

Prof. Dr. HAYRİYE GÖKÇEN ÇETİNKAYA

Kişisel Bilgiler

İş Telefonu: [+90 484 563 5](tel:+904845635)

Fax Telefonu: [+90 484 364 9](tel:+904843649)

E-posta: gokcencetinkaya@gazi.edu.tr

Web: <https://avesis.gazi.edu.tr/gokcencetinkaya>

Uluslararası Araştırmacı ID'leri

ORCID: 0000-0002-4681-3037

Publons / Web Of Science ResearcherID: CAG-0770-2022

Yoksis Araştırmacı ID: 164921

Eğitim Bilgileri

Doktora, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik (Dr), Türkiye 2012 - 2015

Yüksek Lisans, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik (YI) (Tezli), Türkiye 2010 - 2011

Lisans, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Türkiye 2005 - 2010

Yaptığı Tezler

Doktora, Au/(1 grafen (GP) katkılı)-Ca_{1.9}Pr_{0.1}Co₄O_x/n-Si Schottky engel diyotların hazırlanması ve elektrik ile dielektrik özelliklerinin sıcaklık ve frekansa bağlı incelenmesi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik (Dr), 2015

Yüksek Lisans, Au/(Bi-katkılı) polivinil alkol/n-si schottky engel diyotlarının elektriksel özelliklerinin sıcaklığa ve aydınlatma şiddetine bağlı incelenmesi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik (YI) (Tezli), 2011

Araştırma Alanları

Temel Bilimler

Akademik Unvanlar / Görevler

Prof. Dr., Gazi Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Tıbbi Hizmetler Ve Teknikleri Bölümü, 2023 - Devam Ediyor

Doç. Dr., Gazi Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Tıbbi Hizmetler Ve Teknikleri Bölümü, 2018 - 2023

Öğretim Görevlisi, Gazi Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Tıbbi Hizmetler Ve Teknikleri Bölümü, 2012 - 2018

Akademik İdari Deneyim

MYO Müdürü, Gazi Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Tıbbi Hizmetler Ve Teknikleri Bölümü, 2023 - Devam Ediyor

Bölüm Başkanı, Gazi Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Tıbbi Hizmetler ve Teknikleri Bölümü, 2022 - Devam Ediyor

MYO Müdür Yardımcısı, Gazi Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Tıbbi Hizmetler Ve Teknikleri Bölümü, 2022 - 2023
Bölüm Başkan Yardımcısı, Gazi Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Tıbbi Hizmetler ve Teknikleri Bölümü, 2020 - 2022
Farabi Programı Kurum Koordinatörü, Gazi Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, 2019 - 2022
Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörü, Gazi Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, 2019 - 2022
Erasmus Programı Kurum Koordinatörü, Gazi Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, 2018 - 2022

Verdiği Dersler

Medikal Görüntüleme ve Teknikleri, Yüksek Lisans, 2023 - 2024
RADYOLOJİYE GİRİŞ, Ön Lisans, 2023 - 2024
RADYOLOJİK GÖRÜNTÜLEME FİZİĞİ II, Ön Lisans, 2023 - 2024
Doğrusal Olmayan Optik Özellikler, Yüksek Lisans, 2022 - 2023
MESLEKİ UYGULAMA, Ön Lisans, 2020 - 2021
BİYOMEDİKAL TEKNOLOJİ, Ön Lisans, 2020 - 2021
MESLEKİ İNGİLİZCE, Ön Lisans, 2020 - 2021
SOSYAL SORUMLULUK, Ön Lisans, 2020 - 2021
Biyofizik, Ön Lisans, 2020 - 2021
SOSYAL SORUMLULUK, Ön Lisans, 2017 - 2018, 2016 - 2017
GENEL FİZİK-1, Lisans, 2017 - 2018, 2016 - 2017
NÜKLEER TIP, Ön Lisans, 2017 - 2018, 2016 - 2017
MEKANİK LABORATUVARI, Lisans, 2017 - 2018, 2016 - 2017
TEMEL FİZİK, Ön Lisans, 2017 - 2018, 2016 - 2017
BİYOMEDİKAL, Ön Lisans, 2017 - 2018, 2016 - 2017
GENEL FİZİK 2, Lisans, 2017 - 2018
BİYOFİZİK, Ön Lisans, 2017 - 2018, 2016 - 2017
BİYOMEDİKAL TEKNOLOJİ, Ön Lisans, 2017 - 2018, 2016 - 2017
MEDİKAL TEKNOLOJİ, Ön Lisans, 2017 - 2018, 2016 - 2017
ARAŞTIRMA PROJESİ, Ön Lisans, 2017 - 2018, 2016 - 2017
MESLEKİ İNGİLİZCE, Ön Lisans, 2017 - 2018, 2016 - 2017
ELEKTRİK LABORATUVARI, Lisans, 2017 - 2018, 2016 - 2017
GENEL FİZİK 1, Lisans, 2017 - 2018
GENEL FİZİK-2, Lisans, 2016 - 2017
TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ, Ön Lisans, 2016 - 2017

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

- I. **Investigation of the frequency effect on electrical modulus and dielectric properties of Al/p-Si structure with %0.5 Bi:ZnO interfacial layer**
Bengi S., ÇETİNKAYA H. G., ALTINDAL Ş., DURMUŞ P.
Ionics, cilt.30, sa.6, ss.3651-3659, 2024 (SCI-Expanded)
- II. **The Frequency Dependent of Main Electrical Parameters, Conductivity and Surface States in the Al/(%0.5 Bi:ZnO)/p-Si/Au (MIS) Structures**
ÇETİNKAYA H. G., Bengi S., DURMUŞ P., Demirezen S., ALTINDAL Ş.
Silicon, cilt.16, sa.5, ss.2315-2322, 2024 (SCI-Expanded)
- III. **The capacitance/conductance and surface state intensity characteristics of the Al/(CMAT)/p-Si structures**
ÇETİNKAYA H. G., Bengi S., SEVGİLİ Ö., ALTINDAL Ş.

Physica Scripta, cilt.99, sa.2, 2024 (SCI-Expanded)

- IV. **Examination of Electrical and Dielectric Parameters of Au/n-Si Schottky Barrier Diodes (SBDs) with Organic Perylene Interlayer Using Impedance Measurements Under Various Illumination Intensities**
Bengi S., ÇETİNKAYA H. G., ALTINDAL Ş., Zeyrek S.
Journal of Electronic Materials, 2024 (SCI-Expanded)
- V. **Frequency-dependent electrical parameters and extracted voltage-dependent surface states in Al/DLC/p-Si structure using the conductance method**
ŞAFAK ASAR Y., Feizollahi Vahid A., Basman N., ÇETİNKAYA H. G., ALTINDAL Ş.
Applied Physics A: Materials Science and Processing, cilt.129, sa.5, 2023 (SCI-Expanded)
- VI. **The investigation of current-transport mechanisms (CTMs) in the Al/(In₂S₃:PVA)/p-Si (MPS)-type Schottky barrier diodes (SBDs) at low and intermediate temperatures**
Demirezen S., Arslan Alsaç A., ÇETİNKAYA H. G., ALTINDAL Ş.
Journal of Materials Science: Materials in Electronics, cilt.34, sa.14, 2023 (SCI-Expanded)
- VII. **On the wide range frequency and voltage dependence of electrical features and density of surface states of the Al/(Cu:DLC)/p-Si/Au Schottky diodes (SDs)**
ÇETİNKAYA H. G., Feizollahi Vahid A., Basman N., Demirezen S., ŞAFAK ASAR Y., ALTINDAL Ş.
Journal of Materials Science: Materials in Electronics, cilt.34, sa.9, 2023 (SCI-Expanded)
- VIII. **Vertical CdTe:PVP/p-Si - Based Temperature Sensor by Using Aluminum Anode Schottky Contact**
ÇETİNKAYA H. G., Cicek O., ALTINDAL Ş., Badali Y., Demirezen S.
IEEE Sensors Journal, cilt.22, sa.23, ss.22391-22397, 2022 (SCI-Expanded)
- IX. **Doping rate, Interface states and Polarization Effects on Dielectric Properties, Electric Modulus, and AC Conductivity in PCBM/NiO:ZnO/p-Si Structures in Wide Frequency Range**
Demirezen S., Cetinkaya H. G., ALTINDAL Ş.
SILICON, cilt.14, sa.14, ss.8517-8527, 2022 (SCI-Expanded)
- X. **Electrical parameters of Au/(%1Ni-PVA)/n-Si (MPS) structure: Surface states and their lifetimes**
Cetinkaya H. G., Demirezen S., Yeriskin S.
PHYSICA B-CONDENSED MATTER, cilt.621, 2021 (SCI-Expanded)
- XI. **Synthesis, electrical and photo-sensing characteristics of the Al/(PCBM/NiO: ZnO)/p-Si nanocomposite structures**
Demirezen S., Cetinkaya H. G., Kara M., Yakuphanoglu F., ALTINDAL Ş.
SENSORS AND ACTUATORS A-PHYSICAL, cilt.317, 2021 (SCI-Expanded)
- XII. **The fabrication of Al/p-Si (MS) type photodiode with (%2 ZnO-doped CuO) interfacial layer by sol gel method and their electrical characteristics**
ÇETİNKAYA H. G., SEVGİLİ Ö., ALTINDAL Ş.
PHYSICA B-CONDENSED MATTER, cilt.560, ss.91-96, 2019 (SCI-Expanded)
- XIII. **Frequency and Voltage Dependent Profile of Dielectric Parameters and Electric Modulus for Al/(HgS-PVA)/p-Si Capacitor via Impedance Spectroscopy Method**
Cetinkaya H. G.
JOURNAL OF NANOELECTRONICS AND OPTOELECTRONICS, cilt.13, sa.3, ss.421-427, 2018 (SCI-Expanded)
- XIV. **Diode-to-diode variation in dielectric parameters of identically prepared metal-ferroelectric-semiconductor structures**
Cetinkaya H. G., Yildirim M., Durmus P., Altindal Ş.
JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS, cilt.728, ss.896-901, 2017 (SCI-Expanded)
- XV. **Correlation between barrier height and ideality factor in identically prepared diodes of Al/Bi₄Ti₃O₁₂/p-Si (MFS) structure with barrier inhomogeneity**
Cetinkaya H. G., Yildirim M., Durmus P., Altindal Ş.
JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS, cilt.721, ss.750-756, 2017 (SCI-Expanded)
- XVI. **Electrical characteristics of Au/n-Si (MS) Schottky Diodes (SDs) with and without different rates (graphene + Ca_{1.9}Pr_{0.1}Co₄O_x-doped poly(vinyl alcohol)) interfacial layer**
Cetinkaya H. G., Altindal Ş., Orak I., Uslu I.

JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN ELECTRONICS, cilt.28, sa.11, ss.7905-7911, 2017 (SCI-Expanded)

- XVII. **A comparative study on the electrical parameters of Au/n-Si Schottky diodes with and without interfacial (Ca_{1.9}Pr_{0.1}Co_{40x}) layer**
Kaya A., Cetinkaya H. G., Altindal Ş., Uslu I.
INTERNATIONAL JOURNAL OF MODERN PHYSICS B, cilt.30, sa.16, 2016 (SCI-Expanded)
- XVIII. **On the temperature dependent forward bias current-voltage (I-V) characteristics in Au/2% graphene-cobalt doped (Ca₃Co₄Ga_{0.0010x})/n-Si structure**
Maril E., Kaya A., Cetinkaya H. G., Kocyigit S., Altindal Ş.
MATERIALS SCIENCE IN SEMICONDUCTOR PROCESSING, cilt.39, ss.332-338, 2015 (SCI-Expanded)
- XIX. **Electrical and dielectric properties of Au/1% graphene (GP)+Ca_{1.9}Pr_{0.1}Co_{40x} doped poly(vinyl alcohol)/n-Si structures as function of temperature and voltage**
Cetinkaya H. G., Kaya A., Altindal Ş., Kocyigit S.
CANADIAN JOURNAL OF PHYSICS, cilt.93, sa.10, ss.1213-1220, 2015 (SCI-Expanded)
- XX. **Investigation of negative dielectric constant in Au/1 % graphene (GP) doped-Ca_{1.9}Pr_{0.1}Co_{40x}/n-Si structures at forward biases using impedance spectroscopy analysis**
Cetinkaya H. G., Alialy S., Altindal Ş., Kaya A., Uslu I.
JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN ELECTRONICS, cilt.26, sa.5, ss.3186-3195, 2015 (SCI-Expanded)
- XXI. **On the negative capacitance behavior in the forward bias of Au/n-4H-SiC (MS) and comparison between MS and Au/TiO₂/n-4H-SiC (MIS) type diodes both in dark and under 200 W illumination intensity**
Cetinkaya H. G., Yildiz D. E., Altindal Ş.
INTERNATIONAL JOURNAL OF MODERN PHYSICS B, cilt.29, sa.1, 2015 (SCI-Expanded)
- XXII. **Photovoltaic characteristics of Au/PVA (Bi-doped)/n-Si Schottky barrier diodes (SBDs) at various temperatures**
Cetinkaya H. G., Tecimer H., Uslu H., Altindal Ş.
CURRENT APPLIED PHYSICS, cilt.13, sa.6, ss.1150-1156, 2013 (SCI-Expanded)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

- I. **Aynı Şartlarda Hazırlanmış Al/Bi₃Ti₄O₁₂/n-Si (MFS) diyotların (60 Adet) Engel Yükseklikleri İle İdealite Faktörlerindeki Dağılım**
ÇETİNKAYA H. G.
Fen Bilimleri Dergisi PART C: TASARIM VE TEKNOLOJİ, cilt.5, sa.3, ss.89-96, 2017 (Hakemli Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

- I. **Investigation of frequency and voltage dependent dielectric properties, electric modulus and electrical conductivity in the Al/(5 Coumarin doped PVA)/p-Si (MPS) capacitors using impedance spectroscopy method**
DEMİREZEN S., SEÇKİN A. Y., ÇETİNKAYA H. G.
International Materials Science and Nanotechnology for Next Generation (MSNG2018), 4 - 07 Ekim 2018
- II. **A comparative Study on the Au/p-Si diodes with and without different rate (0,1, 0,5, 2) ZnO-doped CuO interfacial layer**
ÇETİNKAYA H. G., ALTINDAL Ş., DEMİREZEN S.
International Materials Science and Nanotechnology for Next Generation (MSNG2018), 4 - 07 Ekim 2018
- III. **Photocurrent characteristics of Au/ p-Si (MS) type photo-diodewith (2 ZnO-doped CuO)/ Interfacial layer by sol gel method**
ALTINDAL Ş., ÇETİNKAYA H. G.

International Materials Science and Nanotechnology for Next Generation (MSNG2018), 4 - 07 Ekim 2018

- IV. **A Comparative Study on The Electrical Characteristics of Au/p-Si diodes with and without different rate (0.1, 0.5 and 2) ZnO-doped CuO interfacial layer**
ÇETİNKAYA H. G., ALTINDAL Ş., DEMİREZEN S.
5th International conference on materials science and nanotechnology for next generation (MSNG2018), 4 - 06 Ekim 2018
- V. **Çeşitli oranlarda ZnO katkılı CuO arayüzey tabakalı Al/p-Si (MS) Diyotlarının Akım-Voltaj (I-V) Karakteristiklerinin Oda Sıcaklığında İncelenmesi**
ÇETİNKAYA H. G., SEÇKİN A. Y.
VII. YOĞUN MADDE FİZİĞİİZMİR TOPLANTISI, Türkiye, 13 Nisan 2018
- VI. **Farklı Oranlarda ZnO Katkılı CuO Arayüzey Tabakalı Al/p-Si (MS) Diyotların Kapasitans-Voltaj (C-V) ve Kondüktans-Voltaj (G/ -V) Karakteristiklerinin İncelenmesi**
ÇETİNKAYA H. G., SEÇKİN A. Y.
VII. YOĞUN MADDE FİZİĞİİZMİR TOPLANTISI, Türkiye, 13 Nisan 2018
- VII. **Dielectric Constant, Electric Modulus and Electrical Conductivity in Identically Prepared Diodes of Al/Bi₄Ti₃O₁₂/p-Si (MFS) Structure with Barrier and Thickness Inhomogeneity**
DURMUŞ P., ÇETİNKAYA H. G., YILDIRIM M., ALTINDAL Ş., DÖKME İ.
4th International conference on materials science and nanotechnology for next generation (MSNG2017), 28 - 30 Haziran 2017
- VIII. **Surface States, Series Resistance and Interfacial Bi₄Ti₃O₁₂ Layer Effects on the Electrical and dielectric Properties of Al/Bi₄Ti₃O₁₂/p-Si (MFS) Structure**
ÇETİNKAYA H. G., YILDIRIM M., DURMUŞ P., ALTINDAL Ş.
4th International conference on materials science and nanotechnology for next generation (MSNG2017), 28 - 30 Haziran 2017
- IX. **Complex Dielectric Constant and Complex Electric Modulus of Al/Bi₄Ti₃O₁₂/p-Si (MFS) Structures as Function of Voltage at Room Temperature**
ÇETİNKAYA H. G., ALTINDAL Ş.
4th International conference on materials science and nanotechnology for next generation (MSNG2017), 28 - 30 Haziran 2017
- X. **The correlation between barrier heights (BHs) and ideality factors (n) in identically prepared Al/Bi₃Ti₄O₁₂/n-Si (MFS) structures**
ÇETİNKAYA H. G.
NANOSCIENCE NANOTECHNOLOGY FOR NEXT GENERATION (NaNONG 2016), 20 - 22 Ekim 2016
- XI. **Electrical and Dielectric Properties in identically fabricated Al/Bi₃Ti₄O₁₂/n-Si (MFS) structures by Capacitance/Conductance-Voltage Measurements**
ÇETİNKAYA H. G., ALTINDAL Ş.
2nd International Advanced and Functional Materials Technologies (AFMAT 2016), 20 - 22 Ekim 2016
- XII. **Electrical and Dielectric Properties in identically fabricated Al Bi₃Ti₄O₁₂ n Si MFS structures by Capacitance Conductance Voltage Measurements**
ÇETİNKAYA H. G., ALTINDAL Ş.
2nd international Advanced and Functional Materials Technologies (AFMAT) 2016, 20 - 22 Ekim 2016
- XIII. **Electrical Characterization and Sources of Energy Losses in Solar Cells**
ALTINDAL Ş., ÇETİNKAYA H. G.
1st International Underground Resources and Energy Conference, 6 - 08 Ekim 2016
- XIV. **Electrical properties of Au/3 Graphene (GP)-doped PVA/n-Si structures as function of frequency**
ÇETİNKAYA H. G., KAYA A., ALTINDAL Ş., ORAK İ.
International Semiconductor Science and Technology Conference 2015 (ISSTC2015), 11 - 13 Mayıs 2015
- XV. **Frequency and voltage-dependent electrical and dielectric properties of Au/Graphene Oxide Calcined/n-Si structures at room temperature**
ALTINDAL Ş., KAYA A., ÇETİNKAYA H. G., USLU İ.
International Semiconductor Science and Technology Conference 2015 (ISSTC2015), 11 - 13 Mayıs 2015

- XVI. **Some Electrical Properties of Au/n-Si Structures with and without Graphene doped PVA Interfacial Layer**
ÇETİNKAYA H. G., KAYA A., ALTINDAL Ş.
International Semiconductor Science and Technology Conference 2015 (ISSTC2015), 11 - 13 Mayıs 2015
- XVII. **Frequency and voltage Dependent electrical and Dielectrical Properties of AU Graphene Oxide Calcined n Si Structures at Room Temperature**
ALTINDAL Ş., KAYA A., ÇETİNKAYA H. G., USLU İ.
International Semiconductor Science Technology Conference, İzmir, Türkiye, 10 - 13 Mayıs 2015, ss.72
- XVIII. **Temperature and Voltage Dependence of Electrical and Dielectric Properties of Au/1 graphene doped- Ca_{1.9}Pr_{0.1}Co₄O_x/n-Si Structure**
ÇETİNKAYA H. G., KAYA A., ALTINDAL Ş., KOÇYİĞİT S.
Nanoscience Nanotechnology for Next Generation (NanoNGe'14), 20 - 22 Ağustos 2014
- XIX. **On the Origin of Capacitance and Anomalous Peak in the Forward Bias Capacitance-Voltage plots in Au/1 graphene doped-Ca_{1.9}Pr_{0.1}Co₄O_x/n-Si Structure.**
ÇETİNKAYA H. G., ALTINDAL Ş., KAYA A., KOÇYİĞİT S.
Nanoscience Nanotechnology for Next Generation, 20 - 22 Ağustos 2014
- XX. **Investigation of Negative Dielectric Constant at Forward Biases Using Impedance Spectroscopy Analysis in Au/1 graphene doped- Ca_{1.9}Pr_{0.1}Co₄O_x/n-Si Structure**
ÇETİNKAYA H. G., ALİALY S., ALTINDAL Ş., USLU İ., KAYA A.
Nanoscience Nanotechnology for Next Generation, 20 - 22 Ağustos 2014
- XXI. **On the Temperature and Voltage Dependence Forward Bias Current-Voltage (I-V) Characteristics in Au/Ca₃Co₄Ga_{0.001}O_x(2 graphene cobalt)/n-Si Structure**
MARIL E., KAYA A., ÇETİNKAYA H. G., KOÇYİĞİT S., ALTINDAL Ş.
Nanoscience Nanotechnology for Next Generation (NanoNGe'14), 20 - 22 Ağustos 2014
- XXII. **The Effect of Series Resistance on Current-Voltage (I-V) Characteristics of Au/PVA/n-Si Schottky Barrier Diodes (SBDs) in Dark and Under Illumination Conditions**
ÇETİNKAYA H. G., TECİMER H., USLU H.
Mini-Workshop on Surface Science for Inauguration of the Turkish Surface Science Society (TuSSS), Türkiye, 23 Mayıs 2011

Desteklenen Projeler

- Çetinkaya H. G., 1. Çerçeve Programı Projesi, Time to act through Sustainable Experiences to Higher Education Students (TIME2ACT@SD), 2022 - 2025
- Tataroğlu A., Şafak Asar Y., Çetinkaya H. G., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 05/2019-26, 2019 - 2021
- Güzel A., Fırat S., Çetinkaya H. G., Erasmus Projesi, EQF oriented assessment tools for prior learning in adult education, 2018 - 2021
- ÇETİNKAYA H. G., ŞAFAK ASAR Y., TATAROĞLU A., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 05/2018-10, 2018 - 2019
- ÇETİNKAYA H. G., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Aynı koşullarda ve aynı yarıiletken üzerinde büyütülen BTO arayüzey tabakalı (MFS) yapıların temel elektriksel parametrelerinin kıyaslanması, 2017 - 2018
- ÇETİNKAYA H. G., ŞAFAK ASAR Y., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Polimer (Perylene) Arayüzey Tabakasının Diyotun Elektriksel Özellikleri Üzerine Etkisi, 2012 - 2013

Metrikler

- Yayın: 47
Atıf (WoS): 426
Atıf (Scopus): 451
H-İndeks (WoS): 13

H-İndeks (Scopus): 13

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

9th International Conference on Materials Science and Nanotechnology for Next Generation , Katılımcı, Ankara, Türkiye, 2022